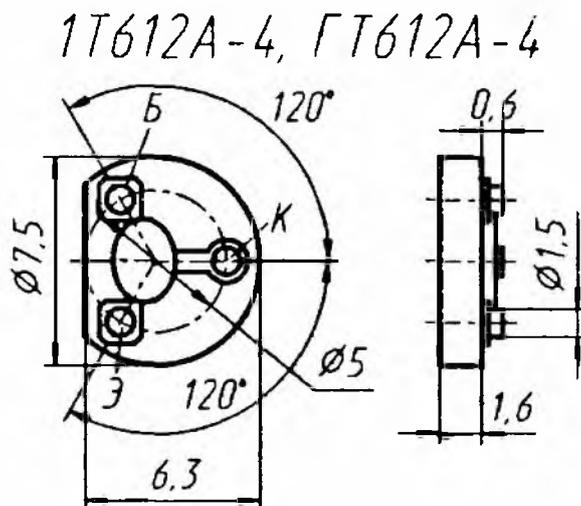


## 1Т612А-4, ГТ612А-4

Транзисторы германиевые планарные структуры *n-p-n* генераторные. Предназначены для усиления и генерирования сигналов сверхвысоких частот в схеме с общей базой. Бескорпусные на керамическом кристаллодержателе с металлизированными контактами выступами и покрытым эмалью кристаллом. Выпускаются в индивидуальной таре-спутнике. Тип прибора указывается на таре.

Масса транзистора не более 0,2 г.



### Электрические параметры

Выходная мощность в режиме автогенератора при  $U_{кб} = 8$  В,  $I_3 = 90$  мА,  $f = 2$  ГГц:

1Т612А-4, не менее .....	150 мВт
медианное значение, не менее .....	180 мВт
ГТ612А-4, не менее .....	200 мВт

Коэффициент усиления по мощности при  $f = 1$  ГГц,  $h_k = 65\%$  для 1Т612А-4, не менее .

Граничная частота при  $U_{кб} = 5$  В,  $I_3 = 50$  мА, не менее .....

Граничное напряжение при  $I_3 = 100$  мА для 1Т612А-4, не менее .....

Постоянная времени цепи обратной связи при  $U_{кб} = 3$  В,  $I_3 = 80$  мА,  $f = 30$  МГц, не более ....

Емкость коллекторного перехода при  $U_{кб} = 5$  В, не более .....

Обратный ток коллектора при  $U_{кб} = 12$  В, не более:

1Т612А-4:	
$T = -60$ и $+25$ °С .....	5 мкА
$T = +70$ °С .....	50 мкА
ГТ612А-4 при $T = +25$ °С .....	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 0,2$ В, не более:	
1Т612А-4:	
$T = -60$ и $+25$ °С .....	5 мкА
$T = +70$ °С .....	50 мкА
ГТ612А-4 при $T = +25$ °С .....	10 мкА

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база .....	12 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{эб} \leq 100$ Ом для 1Т612А-4 .....	8 В
Постоянное напряжение эмиттер—база .....	0,2 В
Постоянный ток коллектора при $T = +25$ °С для ГТ612А-4 .....	120 А
Импульсный ток коллектора при $T = +25$ °С, $t_{и} \leq 10$ мкс, $Q \geq 100$ для 1Т612А-4 .....	200 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
1Т612А-4:	
$T = -60...+35$ °С .....	360 мВт
$T = +70$ °С .....	190 мВт
ГТ612А-4 при $T = +25$ °С .....	360 мВт
Рассеиваемая мощность коллектора в режимах усиления мощности и автогенератора:	
$T = +25$ °С для ГТ612А-4 .....	570 мВт
$T = +35$ °С для 1Т612А-4 .....	570 мВт
$T = +70$ °С .....	225 мВт
Температура $p$ - $n$ перехода .....	+100 °С
Температура окружающей среды:	
1Т612А-4 .....	-55...+70 °С
ГТ610А-4 .....	-60...+70 °С

При эксплуатации транзистора 1Т612А-4 обязательно применение теплоотвода, обеспечивающего тепловое сопротивление переход—окружающая среда не более 138 °С/Вт.